

Tyrystory

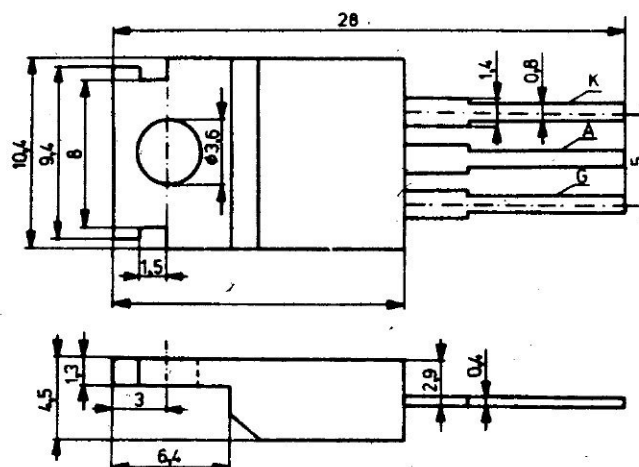
BT

Oznaczenie wyrobu	Parametry graniczne / $t_{amb} = 25^{\circ}\text{C}$, $f_p = 50 \text{ Hz}$ /									Parametry charakterystyczne / $t_{amb} = 25^{\circ}\text{C}$ /									Zasto- sowanie	Obudowa
	U_{DSM}	U_{DRM}	U_{RRM}	I_o	$I_{T/AV/}$	$I_{T/RMS/}$	I_{TSM} I_{FSM}	$\frac{di_T}{dt}$	P_{GM}	U_F , przy		I_{GT}	U_{GT}	przy		U_T przy				
	V	V	V	A	A	A	A	A/ μs	W	V	A	mA	V	V	Ω	V	mA	A		
	max	max	max		max	max	max	max	max	max		max	max			max				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
BTP 128-400	450	400	4	3 ^{1/}	5 ^{1/}	8 ^{1/}	70	200 ^{2/}	25	2	10	45	4	12	30	3	30	0,2	a	CE 30
BTP 128-550	650	550	4	3 ^{1/}	5 ^{1/}	8 ^{1/}	70	200 ^{2/}	25	2	10	45	4	12	30	3	30	0,2	a	CE 30
BTP 129-650	700	650	4	3 ^{1/}	5 ^{1/}	8 ^{1/}	70	200 ^{2/}	25	1,7	10	40	4	12	30	3	30	0,2	a	CE 30
BTP 129-750	800	750	4	3 ^{1/}	5 ^{1/}	8 ^{1/}	70	200 ^{2/}	25	1,7	10	40	4	12	30	3	30	0,2	a	CE 30

a szybki tyrystor zintegrowany z diodą

 $t_{amb} = -40 \div +85^{\circ}\text{C}$
 $t_{stg} = -40 \div +150^{\circ}\text{C}$

1/ $t_{case} = 60^{\circ}\text{C}$; $\theta = 180^{\circ}$; $f_p = 50\text{ Hz}$

2/ $U_D = U_{DRM}$; $I_G = 50\text{ mA}$; $t_r = 0,1\text{ }\mu\text{s}$


CE 30	TO220		
-------	-------	--	--

Wykaz oznaczeń parametrów technicznych

C_r	pojemność diody przy określonym napięciu wstecznym
$\frac{C_r/U_{R1}}{C_r/U_{R2}}$	stosunek pojemności
$\frac{di_T}{dt}$	krytyczna stromość narastania prądu przewodzenia
f_p	częstotliwość pomiarowa
I_F	prąd przewodzenia
I_{FM}	szczytowy prąd przewodzenia
I_{FRM}	powtarzalny szczytowy prąd przewodzenia
I_{FSM}	niepowtarzalny szczytowy prąd przewodzenia
I_G	prąd bramki
I_{GT}	przełączający prąd bramki
I_O	średni prąd wyprostowany
I_R	prąd wsteczny
i_{rr}	prąd ustalenia charakterystyki wstecznej
I_T	skuteczny prąd przewodzenia tyrystora
$I_{T/AV/}$	średni prąd przewodzenia tyrystora
$I_{T/RMS/}$	skuteczny prąd przewodzenia tyrystora
I_{TSM}	niepowtarzalny szczytowy prąd przewodzenia tyrystora
I_Z	prąd stabilizacji
P_{tot}	moc całkowita
P_{GM}	straty mocy w bramce
Q	dobroć
r_F	rezystancja dynamiczna w kierunku przewodzenia
r_s	rezystancja szeregową
r_Z	rezystancja dynamiczna

R_L	rezystancja obciążenia
t	czas trwania impulsu
t_{amb}	temperatura otoczenia
t_{case}	temperatura obudowy
t_j	temperatura złącza
t_r	czas narastania
t_{rr}	czas ustalania charakterystyki wstecznej
U_D	napięcie blokowania
U_{DRM}	powtarzalne szczytowe napięcie blokowania
U_{DSN}	niepowtarzalne szczytowe napięcie blokowania
U_F	napięcie przewodzenia diody
U_{FSM}	niepowtarzalne szczytowe napięcie przewodzenia
U_{GT}	napięcie przełączające bramki
U_R	napięcie wsteczne
U_{RM}	szczytowe napięcie wsteczne
U_{RRM}	powtarzalne szczytowe napięcie wsteczne
U_{RSM}	niepowtarzalne szczytowe napięcie wsteczne
U_{RWM}	szczytowe napięcie wsteczne pracy
U_T	napięcie przewodzenia tyrystora
U_Z	napięcie stabilizacji
α_{UF}	współczynnik temperatury stabilizacji w kierunku przewodzenia
α_{UZ}	współczynnik temperaturowy napięcia stabilizacji
θ	kąt przepływu